

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 6月19日(金) 9:30~17:30

会場 名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (名古屋市千種区不老町, 地下鉄: 名古屋大学駅から徒歩3分, <http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access/index.html> TEL [052] 789-3588 宮崎誠一)

議題 MOS デバイス・メモリ高性能化—材料・プロセス技術

1. [依頼講演] $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{AlGaIn}/\text{GaIn}$ 構造の界面電子準位評価 ○谷田部然治・橋詰 保 (北大)
2. [依頼講演] 容量過渡分光法による MOCVD n-GaN のトラップ評価 徳田 豊 (愛知工大)
3. [依頼講演] $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Ga}_2\text{O}_3$ 界面構造とその面方位依存性
○上村崇史・ダイワシガマニ キルシナムルティ (NICT)・倉又朗人・山腰茂伸 (タムラ製作所)・東脇正高 (NICT)
4. [依頼講演] 3C/4H 異種ポリタイプ接合を有する SiC MOSFET に対する検討
○野口宗隆・岩松俊明・三浦成久・中田修平・山川 聡 (三菱電機)
5. [依頼講演] SiC/SiO_2 界面における窒素化学状態の結晶面方位依存性
○森 大輔・井上 慧・寺西秀明・瀧川亜樹・広瀬隆之 (富士電機)
6. [依頼講演] SiO_2/SiC MOS 界面の欠陥特性に酸窒化処理が与える影響
○竹内和歌奈 (名大)・山本建策 (デンソー)・坂下満男 (名大)・金村高司 (デンソー)・中塚 理・財満鎮明 (名大)
7. 光電子分光法による熱酸化 $\text{SiO}_2/4\text{H-SiC}$ の化学結合状態及び欠陥準位密度評価
○渡辺浩成・大田晃生・牧原克典・宮崎誠一 (名大)
8. シリコン熱酸化膜の水素アニール効果に関する第一原理計算
○川内伸悟・白川裕規・洗平昌晃 (名大)・影島博之 (島根大)・遠藤哲郎 (東北大)・白石賢二 (名大)
9. 極薄 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ hybrid BOX 層を有する貼り合わせ GeOI 基板の熱処理による電気特性改善
吉田啓資・○竹内正太郎・中村芳明・酒井 朗 (阪大)
10. ALD 及び ECR プラズマ酸化による酸化膜固定電荷密度の制御
○永富雄太・田中慎太郎・長岡裕一・山本圭介・王 冬・中島 寛 (九大)
11. メタルソース/ドレイン Ge CMOS 実現に向けた NiGe/Ge 接合障壁変調機構の解明
○岡 博史・箕浦佑也・浅原亮平・細井卓治・志村考功・渡部平司 (阪大)
12. 金属/Ge 界面への超高 Sn 組成 $\text{Sn}_x\text{Ge}_{1-x}$ 層導入による界面電気伝導特性の制御
○鈴木陽洋 (名大)・柴山茂久 (東大)・坂下満男・竹内和歌奈・中塚 理・財満鎮明 (名大)
13. $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$ エピタキシャル層中の欠陥へ及ぼす熱処理の効果
○浅野孝典・柴山茂久・竹内和歌奈・坂下満男・中塚 理・財満鎮明 (名大)
14. PE-ALD 法で作製した極薄膜 Al_2O_3 ゲート絶縁膜を用いた GIZO TFT の電気特性
○栗島一徳 (明大/物材機構)・生田目俊秀・塚越一仁・大井暁彦・知京豊裕 (物材機構)・小椋厚志 (明大)
15. Fully compatible resistive random access memory with amorphous InGaZnO based thin film transistor fabrication process ○Keisuke Kado・Mutsunori Uenuma・Kriti Sharma・Haruka Yamazaki・Satoshi Urakawa・Yasuaki Ishikawa・Yukiharu Uraoka (NAIST)
16. Ti ナノドットを埋め込んだ Si リッチ酸化膜の抵抗変化特性
○加藤祐介・荒井 崇・大田晃生・牧原克典・宮崎誠一 (名大)
17. [依頼講演] 二層グラフェンのバンドギャップ形成と電極接触抵抗 野内 亮 (阪府大)
18. [依頼講演] 原子薄膜の電氣的極性可変トランジスタ
○中弘 周 (物材機構)・飯島智彦・小川真一・八木克典・原田直樹・林 賢二郎・近藤大雄・高橋 慎 (産総研)・黎 松林・山本真人・林 彦甫 (物材機構)・上野啓司 (埼玉大)・塚越一仁 (物材機構)・佐藤信太郎・横山直樹 (産総研)
19. [依頼講演] High-k/Metal ゲート MoS_2 MOSFET の試作と評価
○森 貴洋 (産総研)・二之宮成樹 (横浜国大)・内田紀行・久保利隆 (産総研)・渡辺英一郎・津谷大樹・森山悟士 (物材機構)・田中正俊 (横浜国大)・安藤 淳 (産総研)

◆応用物理学会; シリコンテクノロジー分科会共催

◎研究会終了後, 懇親会を予定していますので御参加下さい。

【問合先】

黒田理人 (東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: kuroda@fff.niche.tohoku.ac.jp